

# 삼성전자, 최초로 80나노 D램 양산

## 90나노 공정대비 생산성 50% 향상 ... 3세대 연속 최첨단 나노 주도

삼성전자는 세계 최초로 80나노 공정을 512메가비트(Mb) DDR2 D램에 적용해 양산에 돌입한다.

80나노(1나노는 10억분의 1m) D램 공정은 2003년 9월 삼성전자가 세계 최초로 개발한 것으로, D램의 집적도나 데이터 보유특성을 개선할 수 있는 3차원 트랜지스터기술(RCAT)이 적용됐다.

80나노 공정을 적용하면 현재 주력 공정인 90나노 공정 대비 생산성이 50% 이상 향상되며 기술상의 연속성으로 추가 투자도 최소화할 수 있다.

삼성전자는 2003년 최초로 100나노 공정을 통해 D램 양산을 시작한 이후 2004년 90나노에 이어 80나노 D램 양산에 돌입함으로써 3세대 연속 최첨단 나노 D램 기술을 주도하게 됐다.

D램 제조를 위한 공정기술이 미세할수록 생산량은 증가하기 때문에 전자기업들은 미세 공정기술의 개발과 양산에 주력하고 있다.

삼성전자는 현재 시장에서 D램의 주력제품으로 부상한 DDR2 D램에 80나노 공정을 우선 적용한 뒤 앞으로 다른 D램 제품군으로 확대 적용해나갈 방침이다.

삼성전자는 2005년 70나노 D램 공정기술도 개발했으며, 2006년 하반기에는 기술을 적용한 제품을 양산할 계획이다. (서울=연합뉴스 김지훈 기자) <저작권자(c)연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/03/14>